# “宽禁带半导体材料与器件”专题

# 征文通知

KUANJINDAI BANDAOTI CAILIAO YU QIJIAN ZHUANTI ZHENGWEN TONGZHI

一代材料催生一代器件，引领一代产业。以Ⅲ族氮化物、碳化硅、氧化物半导体等为代表的宽禁带半导体材料是发展高能效的半导体光电子和电力电子器件的核心基础。宽禁带半导体材料与器件围绕国民经济和社会发展的战略性、基础性和前瞻性方向，重点面向固态照明、新型半导体显示、射频电力电子以及光电探测、绿色能源等前沿领域，对于赋能低碳排放的“美丽中国建设”，聚力“国防科技自主创新、原始创新”，“加速战略性前沿性颠覆性技术发展”以及深入推进光电子技术的发展具有重要意义。

《半导体光电》拟在 2022 年第三期推出“宽禁带半导体材料与器件”专题，报道有关在宽禁带半导体材料与器件及应用方面的最新研究成果、发展现状和趋势，以期为相关领域的专家、学者提供一个学术技术交流平台，推动宽禁带半导体材料与相关器件的发展。

欢迎相关领域的专家学者、科研人员踊跃投稿！

## 特邀专题主编

刘　斌（南京大学 博士，长江学者特聘教授，博士生导师）
张佰君（中山大学 博士，教授，博士生导师）
张源涛（吉林大学 博士，教授，博士生导师）

## 一、征稿方向（包括但不限于以下方向）

（1）宽禁带半导体材料和外延技术
（2）LED 照明与显示材料及器件
（3）射频与电力电子器件
（4）太阳电池与光电探测器件
（5）集成芯片与应用技术

## 二、投稿注意事项

（1）投稿方式：通过《半导体光电》官网（http://www.semiopto.net）进行在线投稿，投稿时请选择栏目“宽禁带半导体材料与器件专题”，并注明推荐人。
（2）稿件格式：可根据《半导体光电》网站首页资料中心的论文排版模板进行编排。
（3）稿件形式及篇幅：综述稿和科研论文均可，篇幅不限，鼓励长文；参考文献建议不少于 20 条。
（4）要求文章为原创且不存在一稿多投。综述稿应注重实效性、全局性和前瞻性，研究论文应突出学术性、前沿性和创新性。

## 三、时间节点

投稿截止时间：2022 年 5 月 30 日
录用截止时间：2022 年 6 月 10 日
专题出版时间：2022 年 6 月 30 日

官网

微信公众号

## 四、咨询和联系方式

联系人：朱玲瑞
QQ：94677628
官网网址：www.semiopto.net
电　话：023-65860286；13883127043
E-mail：soe@163.net
微信公众号：半导体光电期刊